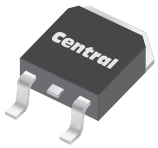
CJD122 NPN
CJD127 PNP

SURFACE MOUNT SILICON COMPLEMENTARY POWER DARLINGTON TRANSISTORS



DPAK CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CJD122 and CJD127 are complementary silicon power Darlington transistors manufactured in a surface mount package designed for low speed switching and amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: (T_C=25°C unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNITS
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Continuous Collector Current	I_C	8.0	A
Peak Collector Current	I_{CM}	16	A
Continuous Base Current	I_B	120	mA
Power Dissipation	P_D	20	W
Power Dissipation (T_A=25°C)	P_D	1.75	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JC}	6.25	°C/W
Thermal Resistance	Θ_{JA}	71.4	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_C=25°C unless otherwise noted)

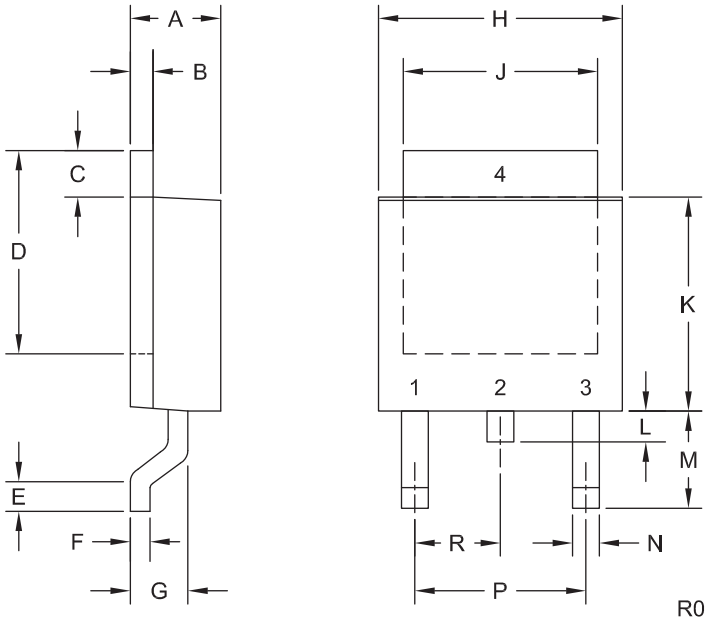
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CEO}	V_{CE}=50V		10	μA
I_{CEV}	V_{CE}=100V, $V_{BE(off)}$=1.5V		10	μA
I_{CEV}	V_{CE}=100V, $V_{BE(off)}$=1.5V, T_C=125°C		500	μA
I_{CBO}	V_{CB}=100V		10	μA
I_{EBO}	V_{EB}=5.0V		2.0	mA
BV_{CEO}	I_C=30mA	100		V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=4.0A, I_B=16mA		2.0	V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=8.0A, I_B=80mA		4.0	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=8.0A, I_B=80mA		4.5	V
$V_{BE(ON)}$	V_{CE}=4.0V, I_C=4.0A		2.8	V
h_{FE}	V_{CE}=4.0V, I_C=4.0A	1000	12000	
h_{FE}	V_{CE}=4.0V, I_C=8.0A	100		
f_T	V_{CE}=4.0V, I_C=3.0A, f=1.0MHz	4.0		MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz (CJD122)		200	pF
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz (CJD127)		300	pF
h_{fe}	V_{CE}=4.0V, I_C=3.0A, f=1.0kHz		300	

R3 (21-January 2013)

CJD122 NPN
CJD127 PNP

SURFACE MOUNT SILICON
COMPLEMENTARY
POWER DARLINGTON TRANSISTORS

DPAK CASE - MECHANICAL OUTLINE



R0

LEAD CODE:
1) Base
2) Collector
3) Emitter
4) Collector

MARKING:
FULL PART NUMBER

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.083	0.108	2.10	2.75
B	0.016	0.032	0.40	0.81
C	0.035	0.063	0.89	1.60
D	0.203	0.228	5.15	5.79
E	0.020	-	0.51	-
F	0.018	0.024	0.45	0.60
G	0.051	0.071	1.30	1.80
H	0.248	0.268	6.30	6.81
J	0.197	0.217	5.00	5.50
K	0.209	0.245	5.30	6.22
L	0.025	0.040	0.64	1.02
M	0.090	0.115	2.30	2.91
N	0.012	0.045	0.30	1.14
P	0.180		4.60	
R	0.090		2.30	

DPAK (REV: R0)

R3 (21-January 2013)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9